

EV Group has Unveiled Revolutionary Technology for Advanced Packaging and Transistor Scaling, Enabling 3D IC Integration – August 30, 2023

授濟日永 EVG發布先進封裝與電晶體微縮等3D IC整 合革命性技術

本文共502字

(f) (⊕) (□) (AA) (□) (►) (00:00)
2023/08/30 12:22:11

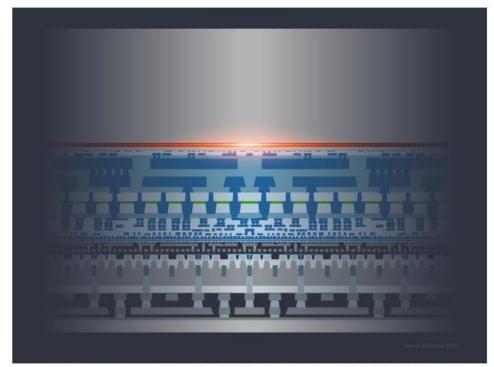
聯合報記者簡永祥/台北即時報導 🚺 🛔 0

微機電系統(MEMS)、奈米科技與半導體市場的晶圓接合暨微影技術設 備領導廠商EV Group(EVG),今天宣布推出NanoCleave技術,這是一 種供矽晶圓使用的革命性薄膜釋放技術,此技術使得先進邏輯、記憶體與 功率元件的製作及半導體先進封裝的前段處理製程,能使用超薄的薄膜堆 疊。

NanoCleave是一種完全與前段相容的薄膜釋放技術,特色是使用紅外線 (IR) 雷射,可穿透對IR雷射波長呈透明狀態的矽晶圓。該項技術搭配使 用特殊配方的無機層,能在奈米級精度下利用IR雷射,從矽載具釋放任何 超薄的薄膜。

因此,NanoCleave技術使得先進封裝製程,例如使用鑄模與重新建構晶 圓的扇出型晶圓級封裝(FoWLP)以及供3D堆疊IC(3D SIC)使用的中 介層等都能使用矽晶圓載具。同時,此技術與高溫製程的相容性,亦為 3D IC及3D序列整合的應用提供全新的製程流程,甚至可與矽載具上超薄 的薄膜完成混合接合與熔融接合,因而為次世代微縮化電晶體設計的3D 與異質整合及材料轉移帶來革命性的進展。

EVG決策團隊並訂9月14日至16日在台北南港展覽館一館舉行的SEMICON Taiwan,分享這項IR雷射轉移技術的突破。



EVG宣布推出NanoCleave技術,是一種供矽晶圓使用的革命性薄膜釋放技術,利用紅 外線雷射剝離技術於矽晶圓達成奈米級精度的薄膜轉移,可讓先進封裝免去使用玻璃基 板,並促成薄膜的3D堆疊。圖/EVG提供

https://money.udn.com/money/story/5612/7404267?from=edn_search_result